

# 2SK532

## シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ( $\pi$ -MOS II)

- 高速大電流スイッチング用
- DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用

### 特 長

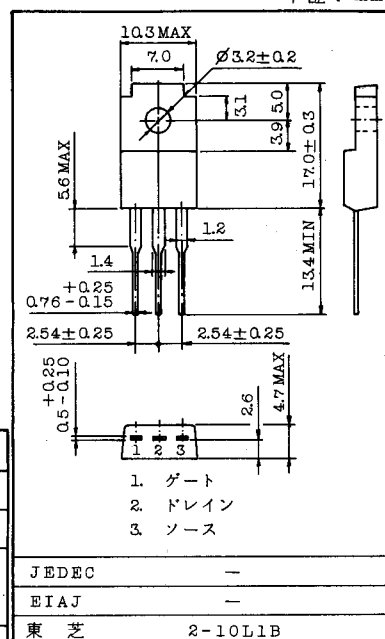
- ・ オン抵抗が低い。:  $R_{DS(ON)} = 0.07\Omega$  (標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。:  $|Y_{fs}| = 5S$  (標準) ( $I_D = 6A$ )
- ・ 漏れ電流が低い。:  $I_{GSS} = \pm 100nA$  (最大) ( $V_{GS} = \pm 20V$ )  
 $I_{DSS} = 1mA$  (最大) ( $V_{DS} = 60V$ )
- ・ 取扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。
- ・ 絶縁プッシング、マイカ等が不要な T0-220 相当のアイソレーションパッケージです。

### 最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSX}$	60	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$\pm 20$	V
ドレイン電流	DC	$I_D$	A
	パルス	$I_{DP}$	
許 容 損 失	$T_a = 25^\circ C$	$P_D$	W
	$T_c = 25^\circ C$		
チャネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$	$-55 \sim 150$	$^\circ C$

通 信 工 業 用

単位: mm



### 電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0$	—	—	$\pm 100$	nA
ドレインシャ断電流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0$	—	—	1.0	mA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0$	60	—	—	V
ゲートしきい値電圧	$V_{th}$	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	—	3.5	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 6A$	2	5	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 6A, V_{GS} = 10V$	—	0.070	0.085	$\Omega$
ドレイン・ソース間オン電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = 12A, V_{GS} = 10V$	—	0.9	1.1	V
入 力 容 量	$C_{iss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	930	1300	pF
帰 還 容 量	$C_{rss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	400	700	pF
出 力 容 量	$C_{oss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	980	1400	pF
スイッチング 時 間	上 昇 時 間	<p><math>I_D = 6A</math> 繰り返し周期 <math>\leq 1\%</math> 入力: <math>t_r, t_f &lt; 5ns</math> (<math>Z_{out} = 50\Omega</math>)</p>	—	100	200	ns
	ターンオン時間		—	120	240	
	下 降 時 間		—	110	220	
	ターンオフ時間		—	190	380	

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。